1



PVモジュール信頼性評価技術

土井卓也



背景と目的

2030年: 寿命30年超のモジュールが期待されている。

太陽電池モジュール: 性能指標(Pmなど)の劣化量は非常に小さい。 (性能指標の初期値からの低下量で寿命を考える) 試験時間の短縮: ストレスを大きくする加速試験 但し、劣化のモード(メカニズム)が変わっては意味がない。 30年相当の寿命試験:複合加速試験でも数ヶ月必要。

精度良く寿命を評価するためには、多数の試験体が必要 太陽電池モジュール: 寸法も大きい→ 多数の試験体は非現実的。

長時間の試験かつ試験体数量(n数)も増やせない: 太陽電池モジュールの特異性を勘案した加速試験方法を確立する。

等価性担保の考え方





===複合加速===



公称開放電圧公称短絡電流

形 寸 法(mm)

量

外

質

選定したモジュール

複合加速試験に用いるモジュール: 多結晶のもの(小型、大型)を選び、主 として小型のもので検討を進めていく事とした。 同形式の2種モジュールはJET(宮古島)にて、屋外暴露試験を実施。

モジュールA	
型式	
公称最大出力	45W
公称最大出力動作電圧	6.0V
公称最大出力動作電流	7.50A

7.4V

8.28A W972×L345×H8(20)

3.7kg



形名		
セル種類		2
公称最大出力	(153W)	
公称最大出力動作電圧	20.30V	
公称最大出力動作電流	7.54A	
公称開放電圧	25.61V	
公称短絡電流	8.21A	
外形寸法(幅X奥行X高さ)	1165×990×46n	ım
質量	14.50kg	
外形図	1	





複合加速試験装置と試験モジュール



加速劣化試験:光照射・高温連続、高温時光照射・温度サイクル試験を実施

A社製モジュールA(多結晶156mm角セル12枚,サイズ:972H×345W) B社製モジュールB(多結晶156mm角セル14枚,サイズ:1180H×355W)



複合劣化試験装置の仕様

項目	仕様・性能
試験温度範囲(光照射なし)	−40~+90°C
試験温度範囲(光照射3SUN以下)	+50∼+90°C
試験槽内湿度(光照射なし,室温以上)	最大RH 85±5%
最大光照射強度	3sun
光照射強度の時間むら	10%以下
光照射強度の場所むら	±15%以内
最大試料寸法	1218H×445W 3枚
注水機能	あり
サイクル試験	JIS C8917 対応



モジュール内セルのIscを分離測定







現行モジュール(多結晶1500×12枚)計算例













条件: 3SUN&設定温度37°C(セル75°C)~ 0SUN&設定温度-40°C、サイクル試験











試験名	全累計時間	ライン番号
3SUN90°C	230時間	1
3SUN75°C,	280時間	2
-20℃サイクル 試験	330時間	3
3SUN75℃、 -40℃サイクル 試験	380時間	4
	480時間	5
	580時間	6

セル番号と端子箱の位置関係: モジュール裏面から見て図で端 子箱の位置を■で示す。



写真は一例:他にも5,6,7,9,10,11,12, 13,14,16番セルに裏面ふくらみあり



第4番セル







独立行政法人產業技術総合研究所





3UV, 90℃連続照射試験

黄変:X(特)-No.12, 16, 17



0 hr



600 hrs



900 hrs



1200 hrs



1400 hrs



味噌用測色計 カラーリーダー CR-13



黄変度の測色計による観察







===要素技術===



不具合事例



バックシートこげ





EVA気泡

エッジのこげ



モジュール不具合事例2



剥離(白濁)と裏面のキズ





気泡



サイクリック試験

想定している加速劣化試験方法



AIST





- 1: DC or wave voltage source
- 2: Bipolar power supply
- 3: PV cell and sample stage
- 4: Damping resistance
- 5: Shunt resistance
- 6: Data logger
- 7: PC
- 8: IR thermographic camera
- 9: Visible Ray camera
- 10: HDD recorder







- ・等高線は負荷条件:S[w]
- 塗りつぶし記号:試験中に破壊
- ・白抜き記号:破壊せず
- ・順バイアス側は0.6Vに固定
- ・逆バイアス側は負荷S[W]をパラ
 メータ





AIST





直列抵抗増加に有効な加速試験方法と示唆される結果が得られた。



降伏破壊の例





まとめ

複合加速試験

- (1)照度に関する因子の係数はモジュールの型式による違いは見られなかったが、温度に関する因子には、大きな違いが見られた。
- (2)追加試験モジュールの結果から、セル・デザイン(フィンガー電極)やジャンクション・ボックス なども不具合症状に影響することが示唆された。

要素技術

- (1)逆バイアス破壊試験の結果、降伏破壊後に見られたコゲは屋外運転中のモジュールでも見 られ、あらたな加速試験として利用可能と考えられる。
- (2) 逆バイアスサイクリック試験の結果、約80W付近に短時間で降伏破壊するか否かの閾値が あることが分かった。また、本試験方法は、セルーインターコネクタ間へストレスを与える劣 化試験と考えられ、劣化要因は直列抵抗の増大が主であった。

今後の展開

逆バイアスサイクリック試験を市販サイズモジュールへの適用を検討する。